

بررسی خواص نوری غیرخطی در نانوساختار دوبعدی MoS₂

افشین علی پور^۱، صغری میرارشادی^۲، سیده زهرا مرتضوی^۳، فرهاد ستاری^۱

^۱ گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

^۲ گروه علوم مهندسی، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، نمین

^۳ گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده - در این مقاله، خواص اپتیکی غیرخطی نانو ساختار دوبعدی MoS₂ با به کارگیری روش جاروب-Z توسط لیزر پیوسته با توان های مختلف ۵۵ و ۱۲ میلی وات در طول موج ۵۳۲ نانومتر مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این خواص اندازه و علامت ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی است که به کمک نمودارهای آزمایش جاروب-Z محاسبه شده است. همچنین پذیرفتاری غیرخطی مرتبه سوم از مرتبه ی (esu) 10^{-7} تعیین گردید. چنین خواص نوری مرتبه سوم بالا، این ساختار را کاندیدای مناسبی جهت بکارگیری در ادوات اپتوالکترونیکی و فوتوترانزیستورها معرفی می کند.

کلید واژه- روش جاروب-Z، خواص اپتیکی غیرخطی، MoS₂

Investigation of Nonlinear Optical Properties in 2D MoS₂ Nanostructures

Afshin Alipour¹, Soghra Mirershadi², Seyedeh Zahra Mortazavi³, Farhad Sattari¹

¹Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Mohagheh Ardabili, Ardabil, Iran

²Department of Advanced Technologies, University of Mohagheh Ardabili, Ardabil, Iran

³Department of Physics, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin

Abstract- In this paper, the nonlinear optical properties of two-dimensional MoS₂ nanostructure are investigated using the Z-scan method by continuous wave lasers with 12 and 55 mW at 532 nm. The properties of the size and sign of the nonlinear refractive index and the nonlinear absorption coefficient are calculated using the Z-scan technique. The corresponding third-order susceptibilities is determined to be as large as 10^{-7} (esu) under laser excitation. This large third-order optical nonlinearity, makes this structure suitable for application of optoelectronic devices and phototransistors.

Keywords: Z-scan technique, Nonlinear optical properties, MoS₂

آنهاست. پاسخ اپتیکی غیرخطی نانو ساختارها به باریکه پرشدت لیزر، امکان به کارگیری این مواد در ادوات اپتوالکترونیکی مانند دیودهای نور گسیل، سلول های خورشیدی و سویچ های اپتیکی را نوید می دهد. روش جاروب-Z، روشی بسیار ساده و در عین حال حساس برای اندازه گیری ضریب جذب غیر خطی و ضریب شکست

۱- مقدمه

طی دهه های اخیر، پژوهش های بسیاری به منظور دسترسی به موادی با خواص نوری غیر خطی بالا و زمان پاسخ کوتاه به سیگنال های نوری صورت گرفته است. یکی از ویژگی های مهم نانو ساختارها، خواص نوری غیر خطی

غیرخطی است. این روش اولین بار توسط شیخ بهایی و همکارانش در سال ۱۹۸۹ ابداع شده است و توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفت [۱]. اخیراً ساختارهای دوبعدی مولیبدن دی سولفید (MoS_2) توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این ساختارها با دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد مانند گاف انرژی تنظیم پذیر، تشکیل اکسایتون پایدار و انرژی پیوند اکسایتونی بالاتر در بسیاری از پژوهشها مورد مطالعه قرار گرفته‌اند [۲-۴]. اما در این پژوهش مطالعه بر روی رفتار نوری غیر خطی MoS_2 به روش جاروب-Z انجام گرفته است.

بدست می‌آید $I_0 = \frac{2P_{in}}{\pi\omega_0^2}$ توان ورودی و ω_0 شعاع باریکه در محل کانون است) که برای توان‌های مختلف ۱۲ و ۵۵ میلی وات، به ترتیب برابر $I_0 = 5.15 \times 10^2$ وات بر سانتی‌متر مربع و $I_0 = 2.26 \times 10^3$ وات بر سانتی‌متر مربع است. همچنین شعاع باریکه در محل کانون $\omega_0 = 39.3$ میکرومتر تعیین گردید. علاوه بر این طول رایلی از رابطه $Z_0 = \frac{\pi\omega_0^2}{\lambda}$ در حدود ۹.۱ میلی‌متر بدست آمد که بسیار بیش‌تر از ضخامت نمونه نانو ساختار (۱۰۰ نانومتر) است. روش جاروب-Z از دو چیدمان تشکیل می‌شود: ۱- جاروب Z با دریچه بسته برای اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی n_2 . ۲- جاروب-Z با دریچه باز برای اندازه‌گیری ضریب جذب غیرخطی β [۱].

تراگسیلندگی خطی و شعاع باریکه در روزنه با استفاده از روابط $\omega_a = \omega_0 \sqrt{1 + z_a^2 / z_0^2}$ و $S = 1 - \exp(-2r_a^2 / \omega_a^2)$ به دست می‌آیند که در آن شعاع روزنه و شعاع پرتو در محل روزنه است [۱]. تراگسیلندگی نور از میان روزنه-ای که در فاصله دور از کانون قرار گرفته است برابر $S=0.54$ تعیین شد.

۳- بحث و بررسی

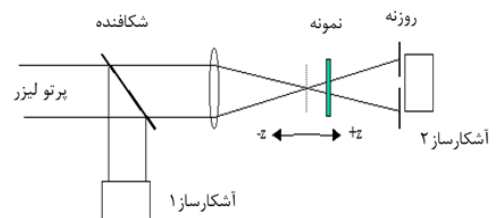
در این تحقیق خواص اپتیکی غیرخطی مرتبه سوم نانو ساختار دوبعدی MoS_2 ، از جمله ضریب شکست غیرخطی n_2 ، ضریب جذب غیرخطی β و پذیرفتاری غیرخطی مرتبه سوم $\chi^{(3)}$ مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین ضریب جذب خطی با استفاده از روش مرسوم آزمایشی تحت تابش با شدت‌های کم پرتو لیزر و در ناحیه خطی پاسخ ماده، توسط رابطه $\alpha_0 = \frac{-1}{l} \ln\left(\frac{I}{I_0}\right)$ تعیین گردید. که در آن I و I_0 به ترتیب بیانگر شدت نور تابشی و عبوری از نمونه و l ضخامت آن است.

با توجه به اینکه امکان به کارگیری نانو ساختارهای دو بعدی مورد مطالعه در ادوات اپتو الکترونیکی پیشرفته، مستلزم شناخت پاسخ نوری غیرخطی آنها می‌باشد، به این خاطر هدف اصلی ما مطالعه بر روی عامل‌های بوجود آورنده رفتار نور غیر خطی در این ساختارها است. در این آزمایش از لیزر پیوسته با توان‌های مختلف ۱۲ و ۵۵ میلی وات با طول موج ۵۳۲ نانومتر استفاده شده است. مطابق شکل (۱) باریکه لیزر پس از خارج شدن از دهانه لیزر توسط شکافنده به دو باریکه تقسیم می‌شود، شدت یکی از این باریکه‌ها به عنوان پرتو مرجع توسط آشکارساز ۱ ثبت می‌گردد و پرتو دیگر به یک عدسی با فاصله کانونی ۱۰۰ میلی‌متر می‌رسد، این پرتو به وسیله عدسی کانونی شده و از نمونه‌های آزمایش که حول کانون عدسی جابجا می‌شوند، عبور کرده و به آشکارساز ۲ می‌رسد.

۲- روش آزمایش

شکل ۱: چیدمان جاروب-Z



شکل ۱: چیدمان جاروب-Z

تحت این شرایط، تابندگی در محل کانون که از رابطه

با محاسبه تفاضل تراگسیلیدگی بهنجار بین قله و دره به صورت $\Delta T_{p-v} = T_p - T_v$ از منحنی برازش شده توسط

$$T(z, \Delta\Phi_0) \approx 1 - \frac{4x}{(x^2 + 9)(x^2 + 1)} \Delta\Phi_0 \quad \text{معادله}$$

می‌توان تغییر فاز روی محور در محل کانون ($|\Delta\Phi_0|$) را توسط رابطه $\Delta T_{p-v} = 0.406(1-S)^{0.27} |\Delta\Phi_0|$ بدست آورد. در ادامه با قرار دادن $\Delta\Phi_0$ در رابطه‌ی

$$n_2 |\Delta\Phi_0| = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) n_2 I_0 L_{eff}$$

را محاسبه نمود [۱]. نتایج حاصل از این محاسبات در جدول (۱) آورده شده است. همانطور که از جدول (۱) پیداست، نانو ساختار MoS_2 تحت هر دو شدت نور لیزر نمونه دارای ضریب شکست غیرخطی بالایی از مرتبه 10^{-7} است. همچنین نتایج حاکی از این می‌باشد که ضریب شکست غیرخطی، با کاهش شدت لیزر افزایش یافته است.

به منظور تعیین ضریب جذب غیرخطی، نانو ساختار MoS_2 از روش جاروب-Z با روزنه باز استفاده شده است. منحنی‌های تراگسیلیدگی بهنجارشده جاروب-Z با روزنه باز برای دو توان مختلف ۵۵ و ۱۲ میلی‌وات در شکل (۳) الف و ب آورده شده است. با جابه جایی نمونه به طرف کانون یک کمینه‌ی در شدت تراگسیل با توان بالاتر لیزر (۵۵ میلی‌وات) مشاهده می‌شود که در شکل (۳) الف آورده شده و بیانگر این است که با افزایش شدت نور لیزر، ضریب جذب غیرخطی کاهش می‌یابد. این موضوع بدلیل رخ دادن پدیده جذب دو فوتونی ($\beta > 0$) در این نوع نانو-ساختار است. همچنین مشاهده یک بیشینه در شدت تراگسیل با توان پایین‌تر لیزر (۱۲ میلی‌وات) بیانگر کاهش ضریب جذب با افزایش شدت نور می‌باشد که به دلیل پدیده جذب اشباع ($\beta < 0$) است.

به وسیله برازش منحنی‌های حاصل از داده‌های تجربی با

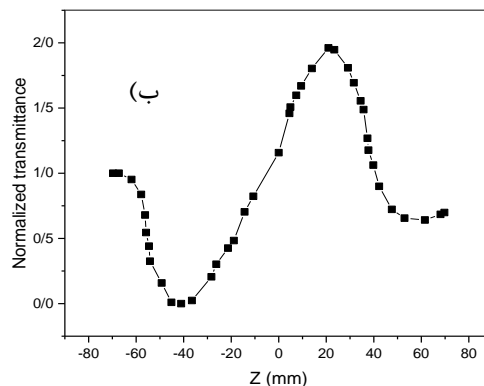
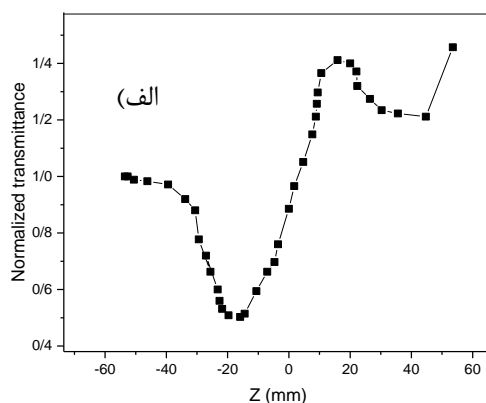
$$\text{رابطه تقریبی} \quad \Delta T(z) \approx \frac{q_0}{2\sqrt{2}} \left[1 / \left(1 + \frac{z^2}{z_0^2} \right) \right]$$

مقدار ضریب q_0 را تعیین نمود و با معلوم بودن آن طبق رابطه‌ی $q_0 = \beta I_0 L_{eff}$ ، می‌توان ضریب جذب اشباع β را بدست آورد [۵]. نتایج حاصل از این محاسبات در جدول

همچنین طول موثر را می‌توان با استفاده از رابطه

$$L_{eff} = \frac{1 - \exp(-\alpha_0 L)}{\alpha_0} \quad \text{بدست آورد [۵].}$$

نمودار تراگسیلیدگی جاروب-Z با روزنه بسته برای نانو ساختار MoS_2 با دو توان‌های لیزر ۵۵ و ۱۲ میلی‌وات به ترتیب در شکل (۲) الف و ب آورده شده است.



شکل ۲: منحنی تراگسیلیدگی جاروب-Z با روزنه بسته در نانو ساختار MoS_2 برای توان لیزر (الف): ۵۵ میلی‌وات و (ب): ۱۲ میلی‌وات.

کاهش شدت نور عبوری برای حالتی که نمونه قبل از کانون عدسی در حال حرکت است و افزایش شدت برای زمانی که نمونه مورد نظر بعداز کانون قرار دارد، بیانگر پدیده‌ی خودکانونی متناظر با رفتار غیرخطی مثبت است [۱].

(۱) آورده شده است. همچنین قسمت‌های حقیقی و موهومی پذیرفتاری غیر خطی تعیین گرید و نتایج حاصل از آن نیز در جدول (۱) آورده شده است.

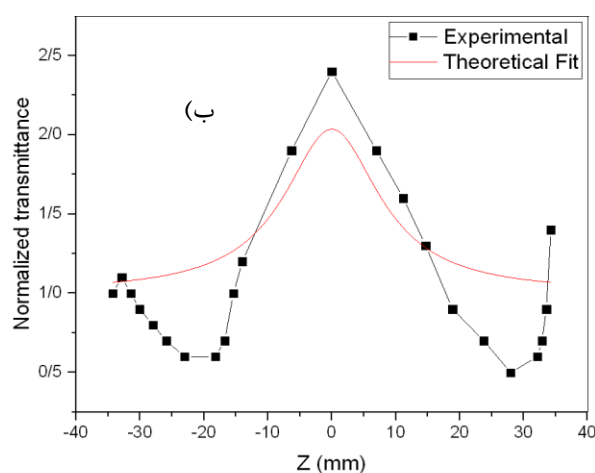
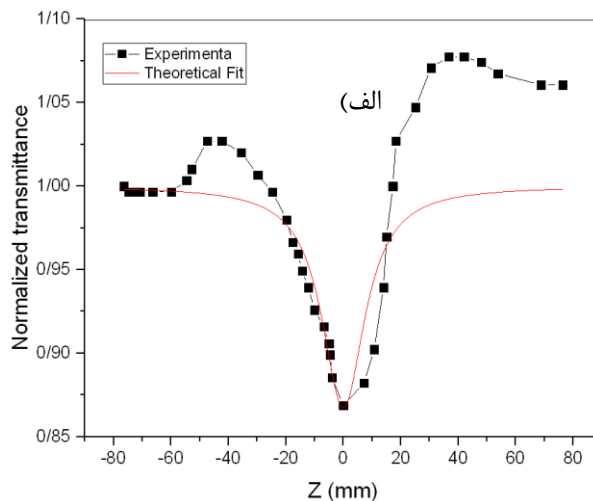
۴- نتیجه گیری

MoS ₂ sample	a_0 (cm ⁻¹)	n_2 (cm ² /W)	β (cm/W)	$\chi^{(3)}$ (m ² /v ²)	Im $\chi^{(3)}$ (esu)	Re $\chi^{(3)}$ (esu)
$P_{in} = 55 \text{ mW}$	1.71×10^5	2.15×10^{-7}	34.2	1.89×10^{-12}	1.41×10^{-8}	9.5×10^{-4}
$P_{in} = 12 \text{ mW}$	2.04×10^5	2.30×10^{-6}	-1.32×10^3	0.45×10^{-13}	1.51×10^{-7}	3.6×10^{-2}

در این مقاله ضریب شکست غیرخطی، ضریب جذب غیرخطی و پذیرفتاری مرتبه سوم نانو ساختار MoS₂ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که ضریب شکست غیرخطی، با کاهش شدت لیزر افزایش یافته است. همچنین با افزایش شدت لیزر در هر اتم با جذب همزمان دو فوتون گذاری از حالت پایه به برانگیخته اتفاق می‌افتد و پدیده جذب دو فوتونی با مشاهده یک دره در نمودار تایید می‌شود.

مراجع

- [۱] M. Sheik-bahae, A. A. Said, E. W. Van Stryland, "High-sensitivity, single-beam n_2 measurements", Opt. Lett., Vol. 14, pp. 955-957, 1989.
- [۲] A. M-Sánchez, K. Hummer, L. Wirtz, "Vibrational and optical properties of MoS₂: From monolayer to bulks", Surface Science Reports, Vol. 70, pp. 554-586, 2015.
- [۳] C. Yim, M. O'Brien, N. McEvoy, S. Winters, I. Mirza, J. G. Lunney, G. S. Duesberg, "Investigation of the optical properties of MoS₂ thin films using spectroscopic ellipsometry", Appl. Phys. Lett. Vol. 104, pp. 103114-103118, 2014.
- [۴] R. Wang, H-C. Chien, J. Kumar, N. Kumar, H-Y. Chiu, H. Zhao "Third-Harmonic Generation in Ultrathin Films of MoS₂", Appl. Mater. Interfaces, Vol. 6, pp. 314-318, 2014.
- [۵] W. Van Stryland and M. Shei-Bahae, "Z-Scan, Characterization Tech-niques and Tabulations for Organic Nonlinear Optical Materials", M. G. Kuzyk and C. W. Dirk, Eds. New York: Marcel Dekker, 1998, pp. 655-692



شکل ۳: منحنی تراگسیلدگی جاروب-Z با روزنه باز در نانو ساختار MoS₂ برای توان لیزر (الف): ۵۵ میلی وات و (ب): ۱۲ میلی وات.

جدول (۱): محاسبات انجام شده آزمایش جاروب-Z